



Зачем нужны патентно-информационные исследования? Почему патентоспособное решение может не обладать патентной чистотой?

Котлов Дмитрий , Руководитель Патентной практики

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» является дочерним обществом Фонда «Сколково», оказывает участникам инновационного проекта «Сколково» и третьим лицам весь комплекс профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение патентных поисков и построение патентных ландшафтов, регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, юридическое сопровождение сделок по российскому и иностранному праву.

Патентные исследования – это информационно-аналитические исследования на основе анализа источников патентной информации с привлечением других видов научно-технической информации.



- Исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности (патентный ландшафт),
- Исследования патентоспособности,
- Анализ патентной чистоты

ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ (охраноспособность) - совокупность свойств технического решения, без наличия которых оно не может быть признано изобретением на основе действующего в данной стране законодательства.



Перед проведением поиска необходимо четко установить предмет поиска



Поиск и формирование массива релевантных документов



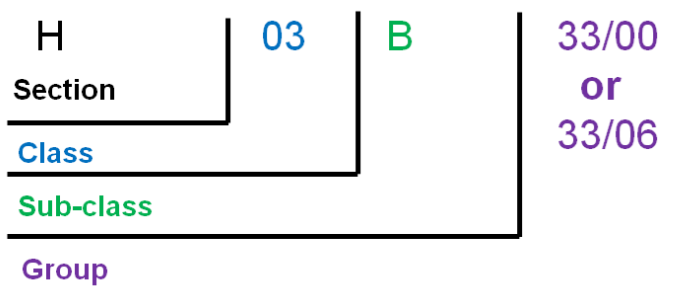
Под **«уровнем техники»** понимают совокупность известных технических решений в определенной области, служащих для оценки технического уровня анализируемого решения, и включающих сведения, ставшие общедоступными в мире на определенную дату.



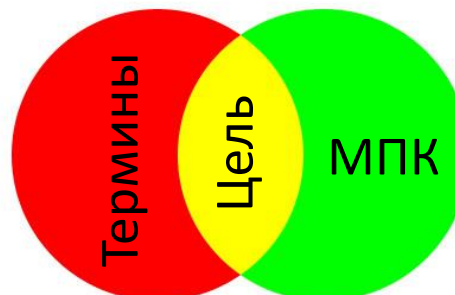
✓ По техническим терминам



✓ По классам



✓ Смешанный



1) ROSPATENT (Federal Institute of Industrial Property)

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/



2) European patent office

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP



3) World Intellectual Property Organization

<http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>



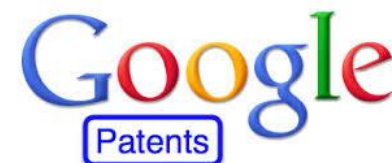
4) USA patent office

<http://patft.uspto.gov>



5) Google patents

http://www.google.com/advanced_patent_search



Поисковый запрос

Вид поиска

Поиск

Основная область запроса **отжиг кремний лазер**

(54) Название

(11) Номер документа

(45) Опубликовано

(21) Заявка

(51) МПК

(71) Заявитель(и)

(72) Автор(ы)

(73) Патентообладатель(и)

(43) Дата публикации заявки

(85) Дата перевода заявки РСТ на национальную фазу

(86) Заявка РСТ

(87) Публикация РСТ

(98) Адрес для переписки

(74) Патентный поверенный

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске

(30) Конвенционный приоритет

(13) Код вида документа

Операторы: and, within, or, adj, not, исключить

Список найденных документов

Внимание! Кнопку браузера "Назад" не нажимать, иначе корректная работа поисковой системы не гарантируется!

Найдено **8** документов

Поиск произведен в библиотеках:

- Рефераты российских изобретений (РИ) (7)
- Заявки на российские изобретения (ЗИ) (7)

Поисковый запрос:

Основная область запроса **отжиг кремний лазер**

№	Номер публикации	Дата публикации	Название	ВД
1.	2362243	2009.07.20	СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КРЕМНИЕВОЙ НАНОСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРА С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ И ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ЕЕ ОСНОВЕ	(РИ)
2.	2011115083	2012.10.27	БАЗОВАЯ ПЛАТА, СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВОЙ ПЛАТЫ И ПОДЛОЖКА УСТРОЙСТВА	(ЗИ)
3.	2007137505	2009.04.20	СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КРЕМНИЕВОЙ НАНОСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРА С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ И ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ЕЕ ОСНОВЕ	(ЗИ)
4.	2002124578	2004.03.27	ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО С НИТРИДНЫМ ПОЛУПРОВОДНИКОМ И СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ К НЕМУ	(ЗИ)
5.	2378750	2010.01.10	УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ ДВУМЕРНОГО ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА	(РИ)
6.	2006124654	2008.01.20	СПОСОБ ВСТРАИВАНИЯ МЕТКИ В АЛМАЗ, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСЛАЖДЕНИЯ	(ЗИ)
7.	2012943	1994.05.15	СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА С ХОЛОДНЫМ КАТОДОМ	(РИ)
8.	1762689	1999.11.20	СПОСОБ ГЕТТЕРИРОВАНИЯ ПРИМЕСЕЙ И ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ	(РИ)

- How many search terms can I enter per field?
- How do I enter words from the title or abstract?
- How do I enter words from the description or claims?
- Can I use truncation/wildcards?
- How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?
- How do I enter the names of persons and organisations?
- What is the difference between the IPC and the CPC?
- What formats can I use for the publication date?
- How do I enter a date range for a publication date search?
- Can I save my query?

Advanced search

Select the collection you want to search in
Worldwide - collection of published applications from 90+ countries

Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in

Enter keywords in English

Title: plastic and bicycle

Title or abstract: hair

Enter numbers with or without country code

Publication number: WO2008014520

Application number: DE19971031696

Priority number: WO1995US15925

Enter one or more dates or date ranges

Publication date: yyyyymmdd

Enter name of one or more persons/organisations

Applicant(s): Institut Pasteur

Inventor(s): Smith

Enter one or more classification symbols

CPC

IPC H03M1/12

Clear Search

Технические признаки

Номера

Даты

Заявитель, Автор

Классификация



Result list

0 results found in the Worldwide database for:
silicon and annealing and excimer and laser and telescope and homogenizer in the title or abstract

Result list

Select all (0/25) Compact Export (CSV | XLS) Download covers

Approximately 256 results found in the Worldwide database for:
silicon and annealing and excimer and laser in the title or abstract

Sort by Upload date Sort order Descending

1.	MONITORING METHOD AND APPARATUS FOR CONTROL OF EXCIMER LASER ANNEALING						
★	<table border="0"> <tr> <td>Inventor: VAN DER WILT PAUL [DE]</td> <td>Applicant: COHERENT LASERSYSTEMS GMBH & CO KG [DE]</td> <td>CPC: G01N2021/0461 G01N2021/0477 G01N21/0788 (+10)</td> <td>IPC: G01N21/04 G01N21/88 G01N21/95 (+2)</td> <td>Publication info: US2015247806 (A1) 2015-09-03</td> <td>Priority date: 2014-03-03</td> </tr> </table>	Inventor: VAN DER WILT PAUL [DE]	Applicant: COHERENT LASERSYSTEMS GMBH & CO KG [DE]	CPC: G01N2021/0461 G01N2021/0477 G01N21/0788 (+10)	IPC: G01N21/04 G01N21/88 G01N21/95 (+2)	Publication info: US2015247806 (A1) 2015-09-03	Priority date: 2014-03-03
Inventor: VAN DER WILT PAUL [DE]	Applicant: COHERENT LASERSYSTEMS GMBH & CO KG [DE]	CPC: G01N2021/0461 G01N2021/0477 G01N21/0788 (+10)	IPC: G01N21/04 G01N21/88 G01N21/95 (+2)	Publication info: US2015247806 (A1) 2015-09-03	Priority date: 2014-03-03		
2.	METHOD FOR MANUFACTURING LOW-TEMPERATURE POLYCRYSTALLINE SILICON THIN-FILM TRANSISTOR AND ARRAY SUBSTRATE						
★	<table border="0"> <tr> <td>Inventor: MAD XUE [CN]</td> <td>Applicant: SOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD [CN]</td> <td>CPC:</td> <td>IPC: H01L21/036 H01L29/786</td> <td>Publication info: WO2015123913 (A1) 2015-08-27</td> <td>Priority date: 2014-02-24</td> </tr> </table>	Inventor: MAD XUE [CN]	Applicant: SOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD [CN]	CPC:	IPC: H01L21/036 H01L29/786	Publication info: WO2015123913 (A1) 2015-08-27	Priority date: 2014-02-24
Inventor: MAD XUE [CN]	Applicant: SOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD [CN]	CPC:	IPC: H01L21/036 H01L29/786	Publication info: WO2015123913 (A1) 2015-08-27	Priority date: 2014-02-24		
3.	PRE-CLEANING METHOD AND PREPARATION METHOD OF LOW-TEMPERATURE POLY SILICON THIN FILM, LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE, AND MANUFACTURING SYSTEM THEREOF						
★	<table border="0"> <tr> <td>Inventor: ZHANG LONGXIAN [CN]</td> <td>Applicant: SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECT [CN]</td> <td>CPC: B08B3/08 C30B25/08 C30B25/10 (+13)</td> <td>IPC: C30B25/08 C30B25/10 C30B25/18 (+2)</td> <td>Publication info: US2015214036 (A1) 2015-07-30</td> <td>Priority date: 2013-12-25</td> </tr> </table>	Inventor: ZHANG LONGXIAN [CN]	Applicant: SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECT [CN]	CPC: B08B3/08 C30B25/08 C30B25/10 (+13)	IPC: C30B25/08 C30B25/10 C30B25/18 (+2)	Publication info: US2015214036 (A1) 2015-07-30	Priority date: 2013-12-25
Inventor: ZHANG LONGXIAN [CN]	Applicant: SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECT [CN]	CPC: B08B3/08 C30B25/08 C30B25/10 (+13)	IPC: C30B25/08 C30B25/10 C30B25/18 (+2)	Publication info: US2015214036 (A1) 2015-07-30	Priority date: 2013-12-25		
4.	Low Temperature Poly-Silicon Thin Film, Method for Making The Thin Film, and Transistor Made from The Thin Film						
★	<table border="0"> <tr> <td>Inventor: ZHANG LONGXIAN [CN]</td> <td>Applicant: SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECT [CN]</td> <td>CPC: H01L21/02532 H01L21/02678 H01L21/02686 (+1)</td> <td>IPC: H01L21/02 H01L29/786</td> <td>Publication info: US2015194310 (A1) 2015-07-09</td> <td>Priority date: 2013-12-25</td> </tr> </table>	Inventor: ZHANG LONGXIAN [CN]	Applicant: SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECT [CN]	CPC: H01L21/02532 H01L21/02678 H01L21/02686 (+1)	IPC: H01L21/02 H01L29/786	Publication info: US2015194310 (A1) 2015-07-09	Priority date: 2013-12-25
Inventor: ZHANG LONGXIAN [CN]	Applicant: SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECT [CN]	CPC: H01L21/02532 H01L21/02678 H01L21/02686 (+1)	IPC: H01L21/02 H01L29/786	Publication info: US2015194310 (A1) 2015-07-09	Priority date: 2013-12-25		

Ограничения:

- 10 признаков (слов)
- 500 документов

Field Combination

Front Page =

AND WIPO Publication Number =

AND Application Number =

AND Publication Date =

AND English Title =

AND English Abstract =

AND Applicant Name =

AND International Class =

AND Inventor Name =

AND Office Code =

AND English Description =

AND English Claims =

AND Licensing availability =

AND Inventor Name = Is Empty: N/A Yes No

Language

English

Stem:

Office:

(+) Add another search field | (-) Reset search fields Tooltip Help

WIPO PATENTSCOPE Search International and National Patent Collections

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Search Browse Translate Options News Login Help

Home > IP Services > PATENTSCOPE

Results 1-200 of 218 for Criteria:EN_AB:(silicon and annealing and excimer and laser) Office(s):all Language:EN Stemming: true

prev 1 2 next Page: 1 / 2 Go >


Refine Search EN_AB:(silicon and annealing and excimer and laser) Search RSS

Analysis

Sort by: Relevance View All List Length 200 Machine translation

Int. Class	Appl. No	Title	Applicant	Inv. Ctr	PubDate
1. 112B8898		EXCIMER LASER ANNEALING APPARATUS, MANUFACTURE OF POLYCRYSTALLINE THIN-FILM TRANSISTOR DEVICE, AND MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE		JP	19.10.1999
G02F 1/136	9131498		TOSHIBA CORP	MIHASHI HIROSHI	
<p>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a liquid crystal display device in display quality and production yield by a method, wherein an excimer laser beam of a conventional excimer laser annealing device is elongated in line length, without having to improve the excimer laser in output or optical systems in performance, and an amorphous silicon layer on a larger array board is turned polycrystalline uniformly.</p> <p>SOLUTION: A peripheral edge 43a of a window frame 43, which supports an annealing window 44 of an excimer laser annealing apparatus 36 is cut obliquely to prevent an excimer laser beam 37 from being reflected from the window frame 43, whereby the excimer laser beam 37 can be expanded in the direction of its major axis as large as the width of the window frame 43, and the excimer laser beam 37 can be elongated in line width.</p> <p>COPYRIGHT: (C)1999, JPO</p>					
2. 1020070050799		METHOD FOR MANUFACTURING SEPARATOR OF ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE DISPLAY DEVICE, PARTICULARLY FOR ENABLING SEPARATOR TO HAVE STABLE OVERHANG STRUCTURE BY FORMING SEPARATOR THROUGH EXCIMER LASER ANNEALING		kr	16.05.2007
H05B 33/22	1020060081926		DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION	LEE, TAE HUN	
<p>PURPOSE: A method for manufacturing a separator of an organic light emitting diode display device is provided to stably perform a role of the separator by more surely separating a cathode layer.</p> <p>CONSTITUTION: A method for manufacturing a separator of an organic light emitting diode display device includes the steps of: forming a silicon nitride layer on a substrate(100); performing excimer laser annealing with different intensities on an annealing area formed on the silicon nitride layer; and wet-etching the silicon nitride layer to leave only the excimer laser annealed area annealed. The annealing area is composed of one to three regions.</p> <p>© KIPO 2007</p>					

Find results	<input type="checkbox"/> with all of the words <input type="checkbox"/> with the exact phrase <input type="checkbox"/> with at least one of the words <input type="checkbox"/> without the words	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="10 results"/> <input type="button" value="Google Search"/>
Patent number	Return patents with the patent number	<input type="text"/>	
Title	Return patents with the patent title	<input type="text"/>	
Inventor	Return patents with the inventor name	<input type="text"/>	
Original Assignee	Return patents with the original assignee name	<input type="text"/>	
Current U.S. Classification	Return patents with the current U.S. classification	<input type="text"/>	
International Classification	Return patents with the international classification	<input type="text"/>	
Cooperative Classification	Return patents with the cooperative classification	<input type="text"/>	
Patent type/status	Return patents with type/status	<input type="text"/>	
Date	<input checked="" type="radio"/> Return patents anytime <input type="radio"/> Return patents between <input type="text"/> and <input type="text"/> e.g. 1999 and 2000, or Jan 1999 and Dec 2000		
Restrict date by	<input checked="" type="radio"/> Restrict by filing date <input type="radio"/> Restrict by issue date		



Web Shopping Images Videos More Search tools

About 43 results (0.48 seconds)

Laser radiating apparatus and methods for manufacturing a ...
www.google.com/patents/US6341042
 Grant - Filed 28 Jan 2000 - Issued 22 Jan 2002 - Shigeki Matsunaka - Kabushiki Kaisha Toshiba
 The process time is shortened by the excimer laser anneal process, ... As a result, the amorphous silicon film can be polycrystallized to form a ... the laser beam L emitted from the telescope 6 is substantially homogenized by a ...
[Overview](#) - [Related](#) - [Discuss](#)

Laser thin film poly-silicon annealing optical system
www.google.com/patents/US7884303
 Grant - Filed 11 Aug 2005 - Issued 8 Feb 2011 - William N. Partlo - Tcz Lic
 This is known as excimer laser annealing "ELA" due to the utilization of an ... including a first telescope lens 32 and a second telescope lens 34, together ... The beam is then passed through a long axis homogenizer 40 ...
[Overview](#) - [Related](#) - [Discuss](#)

Laser thin film poly-silicon annealing system
www.google.com/patents/EP1687877A4?cl=en
 App. - Filed 12 Nov 2004 - Published 8 Oct 2008 - William N Partlo - Tcz Pte Ltd
 This is known as excimer laser annealing "ELA" due to the ... including a first telescope lens 32 and a second telescope lens 34, together forming ... of beam homogenization carried out in the long axis beam homogenizer 40 ...
[Overview](#) - [Related](#) - [Discuss](#)

Анализ с целью проверки
патентоспособности решения



Промышленная применимость

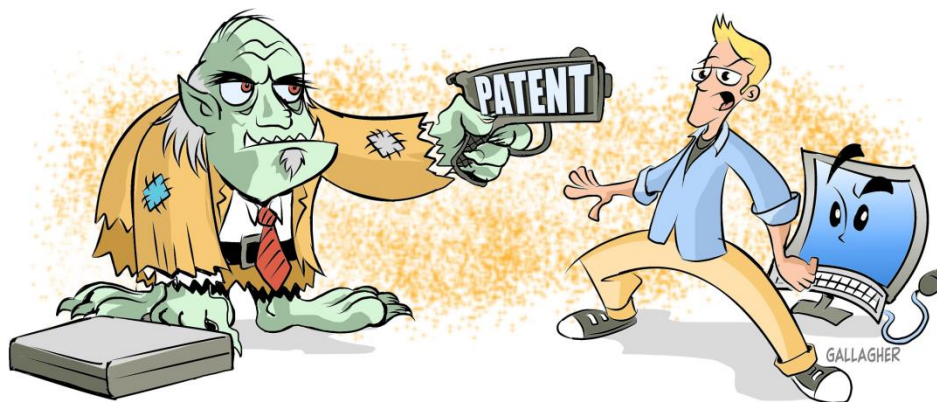


Новизна

Изобретательский уровень



Патентная чистота — юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без нарушения исключительных прав, удостоверенных действующими на ее территории патентами, принадлежащими третьим лицам.



Патентная чистота определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату.



- выявляются действующие патенты, имеющие отношение к объекту в целом или его составным частям;
- проводится сопоставительный анализ на предмет нарушения формул отобранных патентов



Анализ патентной чистоты



Проверяется объект в целом, причем оценке подвергаются все или большинство реализованных в нем технических решений.

Экспертиза ведется по каждой стране в отдельности.

Принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная практика тех стран, в отношении которых ведется экспертиза

Цель экспертизы – выявить использованные в объекте признаки запатентованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках

Во внимание принимаются только действующие в данной стране патенты.

Экспертиза не заканчивается до тех пор, пока не просмотрены все без исключения действующие патенты в данной стране (сплошной или исчерпывающий поиск).

Глубина поиска патентов во времени определяется сроком их действия в данной стране и не должна превышать этого срока.

При изучении патента основное внимание уделяется выявлению объема прав из патента.

Ошибки и неточности могут привести к значительному материальному ущербу, что делает экспертизу весьма ответственной

Критерий	Патентоспособность	Патентная чистота
<i>Глубина поиска документов (годы)</i>	Все материалы до подачи заявки	Патенты, выданные за последние 20 лет
<i>Документы для анализа</i>	Все доступные опубликованные материалы	Действующие патенты
<i>Цель</i>	Минимизация риска отказа в выдаче патента, расходов на делопроизводство и оптимальное определение объёма правовых притязаний	Беспрепятственно производить и продавать разработанный продукт
<i>География</i>	Весь мир	Страны, в которых планируется производить и/или продавать продукт



Спасибо за внимание